

МОЩНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ (Power MOSFET)

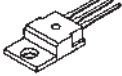
HARRIS является мировым лидером в производстве **Power MOSFET**.

Выпускаются как n-канальные, так и p-канальные транзисторы, но первые используются чаще и имеют больший диапазон токов и напряжений. Кроме этого выпускаются полевые транзисторы с управлением сигналом логического уровня, с ограничением тока, с защелкой по напряжению.

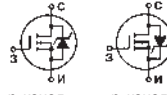
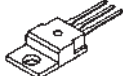
Области применения: регуляторы, конвертеры, драйверы двигателей, реле и мощных биполярных транзисторов.

Полевые транзисторы имеют очень высокое входное сопротивление и обычно могут управляться непосредственно от микросхемы без дополнительных усилительных каскадов.

Power MOSFET, серия IRF

 п-канал			 р-канал																	
Максим. значения																				
$V_{GS}, В$			$I_{DS}, А$			$R_{DS(отр.)}, Ом$			TO-204			TO-220AB			TO-247			DIP-4		
п-канал																				
100	0,4		3,2											IRFD122						
	0,8		0,8											IRFD112						
	1,3		0,3											IRFD120						
	5,6		0,54					IRF510												
	9,2		0,27		IRF120			IRF520												
	14,0		0,16					IRF530												
	28,0		0,077		IRF140			IRF540												
40,0		0,055		IRF150						IRFP150										
200	0,45		2,4											IRFD212						
	0,80		0,8											IRFD220						
	3,3		1,5					IRF610												
	5,0		0,8		IRF220			IRF620												
	9,0		0,4		IRF230			IRF630												
	18,0		0,18		IRF240			IRF640												
	33,0		0,085		IRF250						IRFP250									
400	0,4		3,6											IRFD310						
	2,0		3,6					IRF710												
	3,3		1,8		IRF320															
	5,5		1,0		IRF330			IRF730												
	10,0		0,55		IRF340			IRF740												
	16,0		0,3		IRF350						IRFP350									
	23,0		0,2		IRF360						IRFP360									
500	2,5		3,0		IRF420			IRF820												
	4,5		1,5		IRF430			IRF830												
	8,0		0,85		IRF440															
	14,0		0,4		IRF450						IRFP450									
	20,0		0,27		IRF460						IRFP460									
1000	4,3		3,5								IRFPG40									
р-канал																				
100	1,0		0,6											IRFD9120						
	3,0		1,2					IRF9510												
	6,0		0,6					IRF9520												
	12,0		0,3		IRF9130			IRF9530												
	19,0		0,2		IRF9140			IRF9540			IRFP9140									
200	3,5		1,5					IRF9620												
	6,5		0,8		IRF9230			IRF9630												
	11,0		0,5		IRF9240			IRF9640												

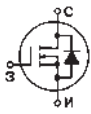
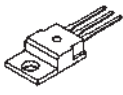
Mega FET серия

			
п-канал		р-канал	
Максим. значения			
$V_{GS}, В$	$I_{DS}, А$	$R_{DS(on)}, Ом$	TO-220AB
п-канал			
50	14	0,1	RFP14N05
	25	0,047	RFP25N05
	50	0,22	RFP50N05
100	22	0,080	RFP22N10
	40	0,040	RFP40N10
р-канал			
50	8	0,300	RFP8P05
	15	0,150	RFP15P05
	30	0,065	RFP30P05
п-канал, управление логическим уровнем			
50	4	0,800	RFP4N05L
	14	0,100	RFP14N05L
	25	0,047	RFP25N05L
	50	0,022	RFP50N05L
100	2	1,050	RFP2N10L
	7	0,300	RFP7N10LE
	12	0,200	RFP12N10L
200	2	3,500	RFP2N20L
	8	0,500	RFP8N20L
р-канал, управление логическим уровнем			
30	10	0,225	RFP10P03L

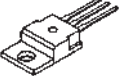


Более подробную информацию можно получить по адресу www.semi.harris.com или заказав литературу непосредственно у **HARRIS**. Бланк для заказа литературы приведен в каталоге.

п-канальные MOSFET, серия BUZ

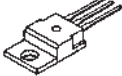
		Максимальные значения			Максимальные значения				
		$V_{GS}, В$	$I_{DS}, А$	$R_{DS(on)}, Ом$	$V_{GS}, В$	$I_{DS}, А$	$R_{DS(on)}, Ом$		
		50	14,0	0,1	BUZ71	200	9,5	0,4	BUZ32
			30,0	0,04	BUZ11	400	3,0	1,8	BUZ76
			9,0	0,25	BUZ72A		5,5	1,0	BUZ60
		100	19,0	0,1	BUZ21	500	4,0	2,0	BUZ42
			5,8	0,6	BUZ73A	1000	4,3	3,5	RFP4N100

Улучшенные Power MOSFET

			
		TO-220AB	
Максим. значения			
$V_{GS}, В$	$I_{DS(огр.)}, А$	$R_{DS(on)}, Ом$	
80	1	0,75	RLP1N08LE
	5,5	0,12	RLP5N08LE

RLP1N08LE, RLP5N08LE

Имеют встроенную схему, ограничивающую max значения I_{DS} на уровне 1 А и 5,5 А соответственно. Встроенный стабилизатор защищает от статического электричества до 2 кВ.

			
		TO-220AB	
Максим. значения			
$V_{GS}, В$	$I_{DS(огр.)}, А$	$R_{DS(on)}, Ом$	
55	1	0,75	RLP1N06CLE

RLP1N06CLE

Имеют схему ограничения I_{DS} , защелку по напряжению (уровень 60÷70 В), встроенный стабилизатор для защиты от статического электричества до 2 кВ.